








	<h2>SI1489EDH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1489EDH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 2A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  SI1489EDH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 88944 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1489EDH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 2A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	88944 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 2A (Tc) 2.8W (Tc) Surface Mount SOT-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Verlustleistung (max)	2.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	48 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1489EDH-T1-GE3CT

SI1489EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1489EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1489EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1489EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1488DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1488DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1499DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC70-6</p>	 <p>SI1499DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC70-6</p>
 <p>SI1488DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1480DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 2.6A SOT-363</p>	 <p>SI1488DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1499DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1441EDH-T1-GE3	↔ SI1442DH-T1-GE3	⇒ SI1442DH-T1-GE3	D SI1443EDH-T1-GE3	⇒ SI1443EDH-T1-GE3
⊖ SI1467DH-T1-GE3	⊕ SI1467DH-T1-GE3	D SI1469DH-T1-GE3	⇒ SI1469DH-T1-GE3	⇒ SI1470DH-M6TR
⊕ SI1470DH-T1-GE3	⊖ SI1470DH-T1-GE3	⊕ SI1471DH-T1	↔ SI1471DH-T1-E3	⇒ SI1471DH-T1-E3
D SI1471DH-T1-GE3	⊕ SI1471DH-T1-GE3	⊖ SI1472DH-T1-E3	⊕ SI1472DH-T1-E3	⇒ SI1473DH-T1-E3
⇒ SI1473DH-T1-E3	↔ SI1473DH-T1-GE3	⊕ SI1473DH-T1-GE3	⊖ SI1488DH-T1-GE3	⇒ SI1488DH-T1-GE3
↔ SI1489EDH-T1-GE3	⇒ SI1499DH-T1-GE3	D SI1499DH-T1-GE3	⊕ SI1501DL	⊖ SI1501DL-T1
⊕ SI1501DL-T1-E3	D SI1501DL-T1-GE3	⇒ SI1539CDL-T1-GE3	↔ SI1539CDL-T1-GE3	⇒ SI1539DL
⊖ SI1539DL-T1-E3	⊕ SI1539DL-T1-E3	↔ SI1539DL-T1-GE3	⇒ SI1539DL-T1-GE3	⇒ SI1551DL
⊕ SI1551DL-S6-E3	⊖ SI1551DL-T1	⊕ SI1551DL-T1-E3	D SI1551DL-T1-E3	⇒ SI1551DL-T1-GE3
↔ SI1551DL-T1-GE3	⊕ SI1552AI-JE-DCC-32.768D	⊖ SI1553CDL-T1-GE3	⊕ SI1553CDL-T1-GE3	⇒ SI1553DL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited